

รายการอ้างอิง

- [1] ชัยสิทธิ์ วานิชทวีวัฒน์. “การออกแบบวงจรขยายเสียงแบบวิธีสวิตซ์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟตรงสอง
สองระดับด้วยวิธีอสมการ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- [2] โคทม อารียา. “อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 และ 2”. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2544.
- [3] R.W. Erickson. “Fundamental of Power Electronics”. Chapman & Hall. International
New York ; Thomson Publishing, 1997.
- [4] C.J.Savant,MartinS.Roden, Gordon L.Carpenter. “Electronic Circuit Design an engineering
approach”. The Benjamin/Cummings Publishing Company,Inc, California, 1987
- [5] Jacob Millman, Arvin Grabel. “Microelectronics”. Singapore ; McGraw-Hill book company,
1987.
- [6] David F. Stout,Milton Kaufman. “Handbook of Operational Amplifier Circuit Design”.
New York ; McGraw-Hill book company, 1976.
- [7] Jae Hoon Jeong , Gue Hong Kim , Byeong Rok Min , Che Hong Ahn , Gyu Hyeong Cho ,
“A high Efficiency Class A accompanied by Class D Swithching amplifier,” PESC '97
Record .,vol:2 , pp.1210-1216.
- [8] J. H , Gue H. Kim , Jeong H. Yi , Gyu H. Cho , “A Class D Swithcing Power Amplifier with
High Efficiency and Wide Bandwidth by Dual Feedback Loops,” IEEE , Proceeding of
International Conference on Consumer Electronics , 1995 , pp. 428-429.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

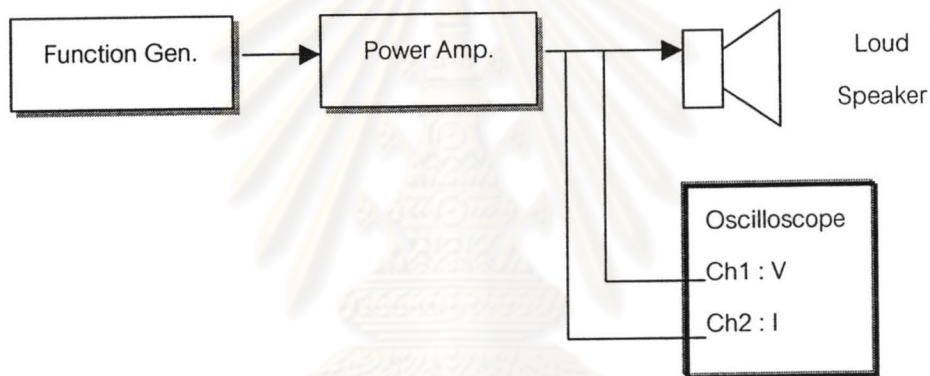
ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

ผลการทดสอบเพื่อหาอิมพีแดนซ์ของลำโพง

เพื่อศึกษาว่าในช่วงความถี่เสียง 20Hz ถึง 20kHz ที่เราใช้งานอยู่ อิมพีแดนซ์ของลำโพงจากของจริงกับแบบจำลองที่กำหนดให้เป็นความต้านทาน 8Ω ต่างกันอย่างไร

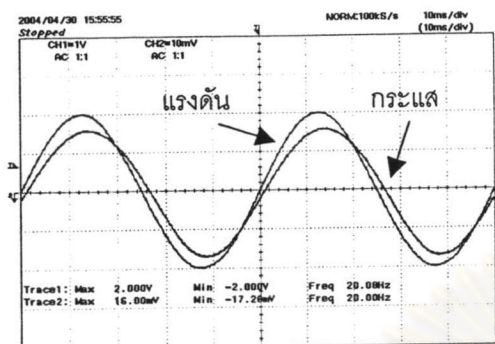
ทดสอบโดยการป้อนแรงดันไซน์ขนาดคงที่ 2 Vp ที่ความถี่ต่าง ๆ แล้ววัดกระแสที่ไหลเข้าลำโพง เมื่อวัดขนาดและเฟสของทั้งแรงดันและกระแสก็นำมาคำนวณหาอิมพีแดนซ์ของลำโพง ภาพวงจรที่ใช้ทดสอบแสดงในรูปที่ ก.1



รูปที่ ก.1 วงจรที่ใช้ทดสอบเพื่อหาอิมพีแดนซ์ลำโพง

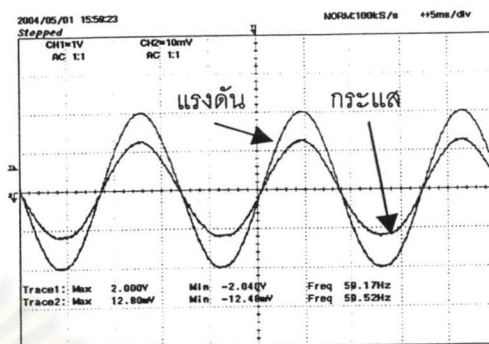
ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างรูปคลื่นแรงดันคร่อมลำโพงและกระแสผ่านลำโพง ที่ความถี่ต่าง ๆ



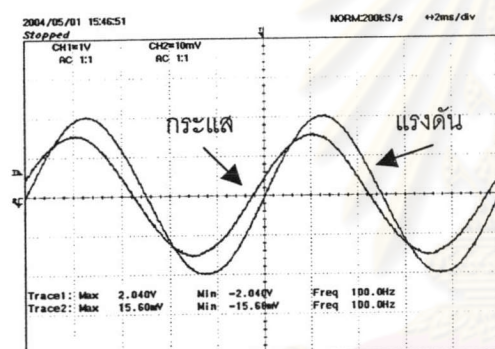
(๑) 20 Hz

สเกลกระแส 200mA/div



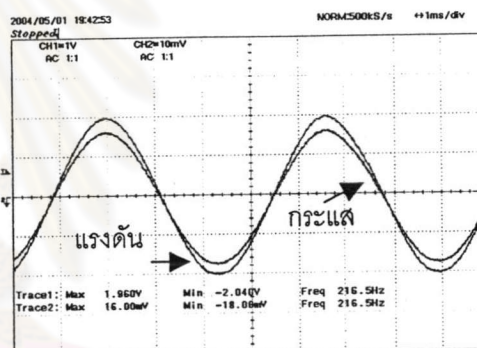
(๒) 59 Hz

สเกลกระแส 100mA/div



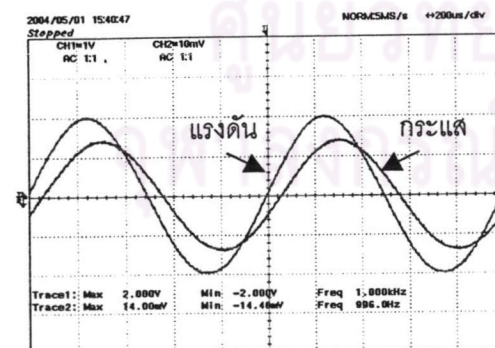
(๓) 100 Hz

สเกลกระแส 200mA/div



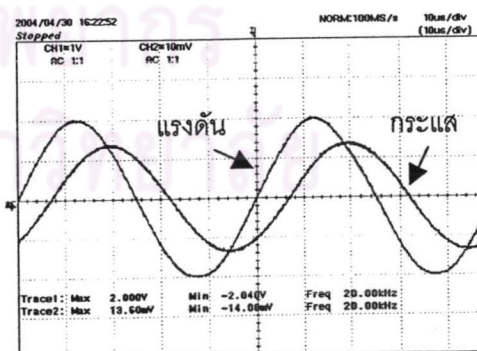
(๔) 216 Hz

สเกลกระแส 200mA/div



(๕) 1kHz

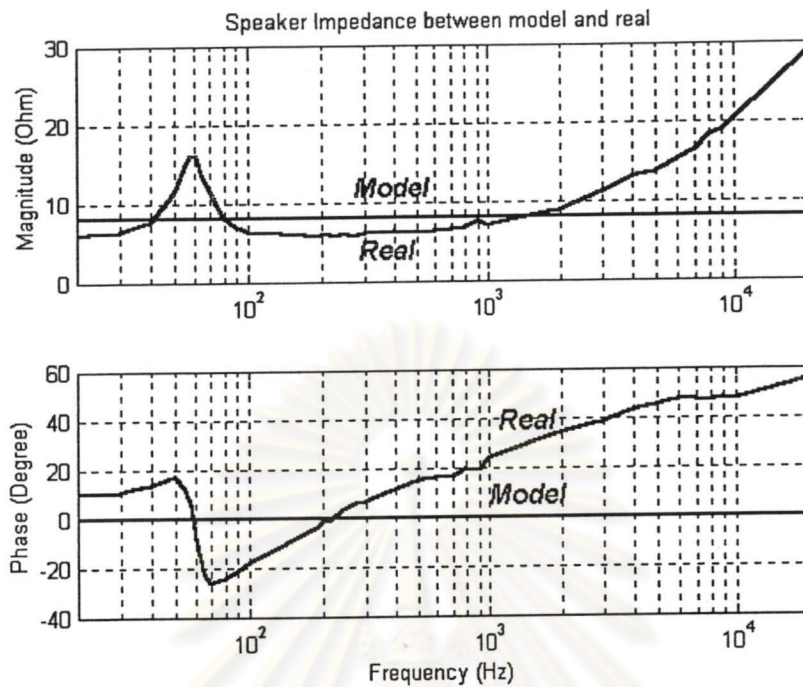
สเกลกระแส 200mA/div



(๖) 20kHz

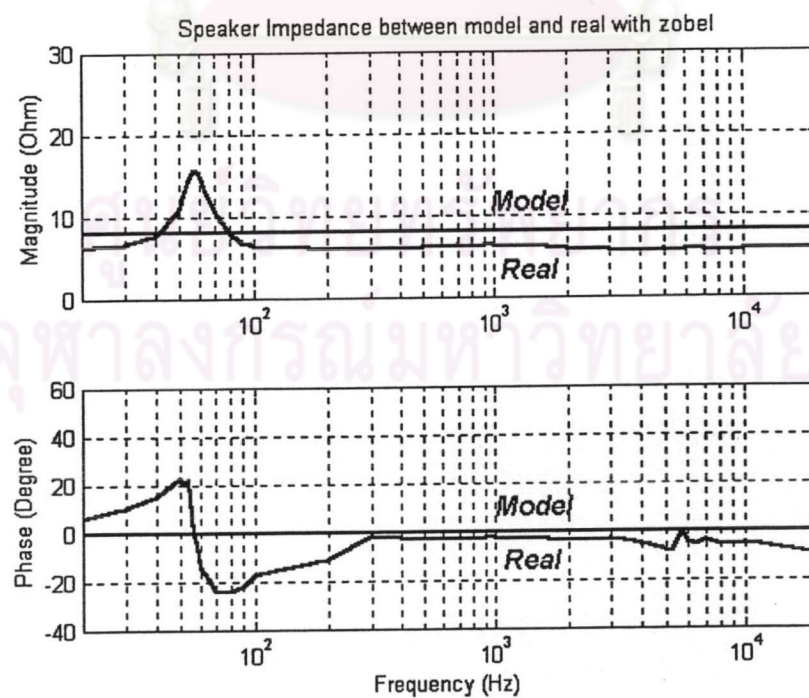
สเกลกระแส 50mA/div

รูปที่ ก.2 รูปคลื่นแรงดันคร่อมลำโพงและกระแสผ่านลำโพง ที่ความถี่ต่าง ๆ



รูปที่ ก.3 อิมพีแดนซ์ของลำโพงที่ได้จากการทดสอบ (Real) และจากแบบจำลอง (Model) R 8 Ω

ทำการชดเชยด้วยวงจรกรองโซเบล (Zobel) [1] โดยเลือกชดเชยที่ความถี่ 800Hz จะได้ $R_{zobel} = 7 \Omega$, $C_{zobel} = 11 \mu F$ ผลการชดเชยวัดค่าอิมพีแดนซ์ลำโพงดังรูปที่ ก.4 ทั้งขนาดและเฟสของอิมพีแดนซ์ลำโพงจริงมีค่าใกล้เคียงกับแบบจำลองมากกว่าก่อนการชดเชย



รูปที่ ก.4 อิมพีแดนซ์ของลำโพง หลังจากชดเชยด้วยวงจรกรอง Zobel

ภาคผนวก ข

ผลการทดสอบสมรรถนะของวงจรตรวจจับสัญญาณผิดเพี้ยน

เพื่อศึกษาความสามารถของวงจรตรวจจับสัญญาณผิดเพี้ยนในแง่การตรวจจับสัญญาณผิดเพี้ยน ณ ความถี่ของสัญญาณเข้าต่าง ๆ กัน

ทดสอบที่กำลังด้านออก 100W ที่ความถี่สัญญาณระหว่าง 20Hz ถึง 20kHz แล้วทำการวัดแรงดันลดทอน (Vatt) , แรงดันด้านเข้าที่ผ่านวงจรหน่วงเวลา (Vin1) , แรงดันด้านผิดเพี้ยน (Verr) และ แรงดันด้านออก (Vo) ด้วยออสซิลโลสโคปในช่องสัญญาณที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับ

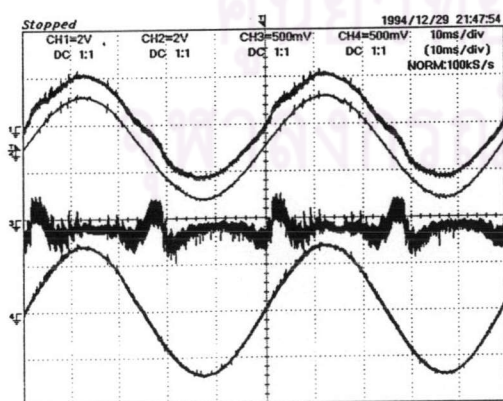
กำลังด้านออก 100วัตต์

ช่องสัญญาณที่ 1 : แรงดันจากวงจรขยายคลาสดีที่ลดทอน (Vatt) สเกล 2V/ช่อง
(กราฟเส้นบนสุด)

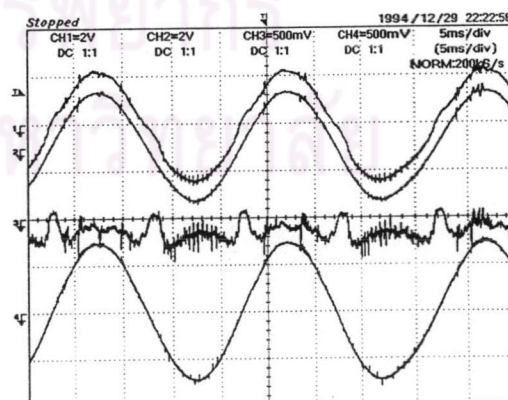
ช่องสัญญาณที่ 2 : แรงดันด้านเข้าที่ผ่านวงจรหน่วงเวลา (Vin1) สเกล 2V/ช่อง
(กราฟเส้นถัดลงมาจากเส้นบนสุด)

ช่องสัญญาณที่ 3 : แรงดันด้านผิดเพี้ยน (Verr) สเกล 0.5V/ช่อง
(กราฟเส้นถัดขึ้นมาจากเส้นล่างสุด)

ช่องสัญญาณที่ 4 : แรงดันด้านออก (Vo) สเกล 25V/ช่อง
(กราฟเส้นล่างสุด)

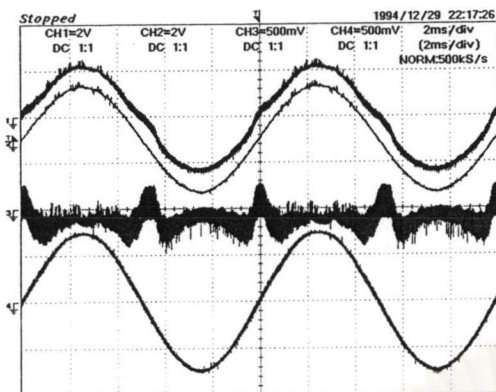


(๑) 20 Hz

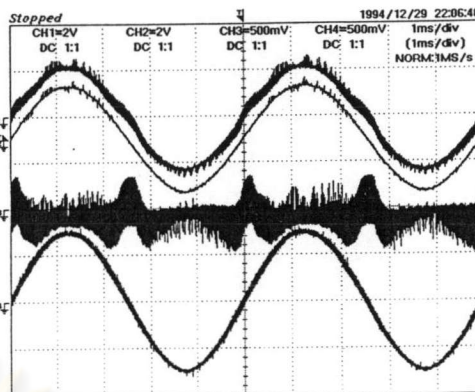


(๒) 50 Hz

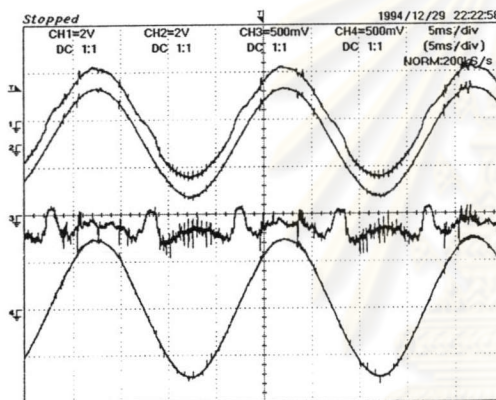
รูปที่ ข.1 รูปคลื่นสัญญาณของวงจรขยายคลาสดีร่วมกับคลาสเอ ณ กำลังด้านออก 100วัตต์



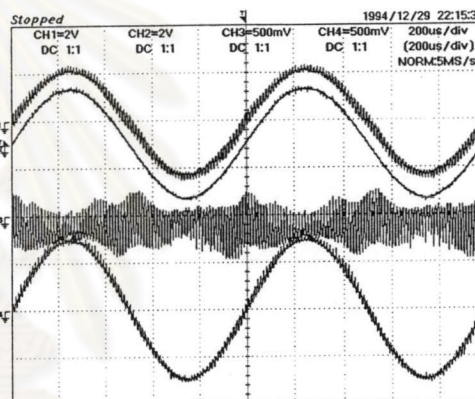
(ก) 100 Hz



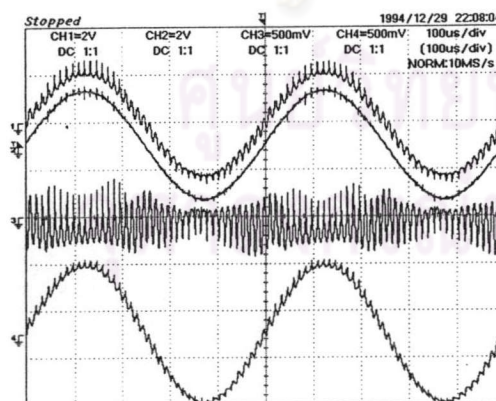
(ข) 200 Hz



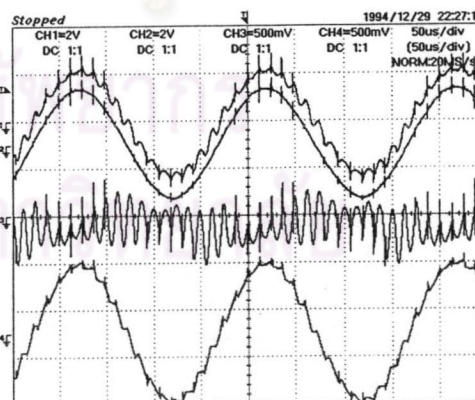
(ค) 500 Hz



(ง) 1 kHz

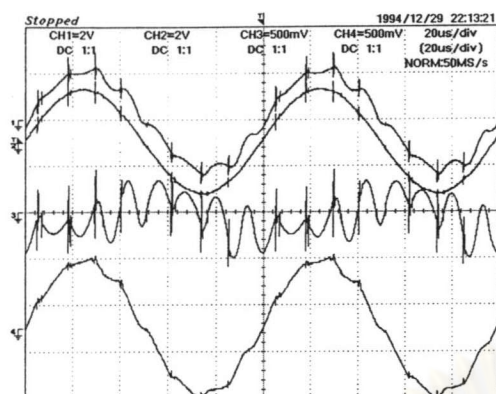


(ฉ) 2 kHz

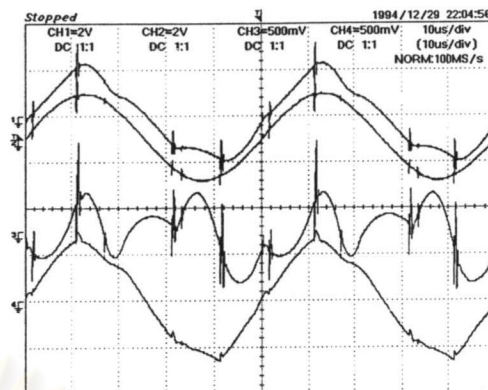


(ช) 5 kHz

รูปที่ ข.1 รูปคลื่นสัญญาณของวงจรขยายคลาสิคี่ร่วมกับคลาสิคเณ กำลังดันออก 100วัตต์ (ต่อ)



(๘) 10 kHz



(๑๐) 20 kHz

รูปที่ ข.1 รูปคลื่นสัญญาณของวงจรขยายคลาสดีร่วมกับคลาสเอ ณ กำลังด้านออก 100วัตต์ (ต่อ)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง เกิดเมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ 2516 ที่เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2538 เข้ารับการศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์กำลัง) ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2544



ศูนย์วิทยพัทธยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย